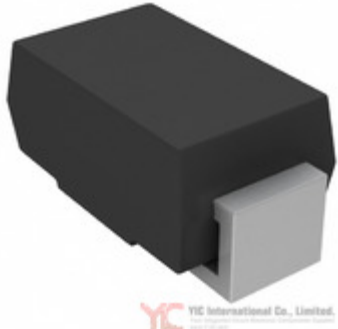
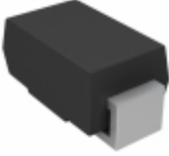
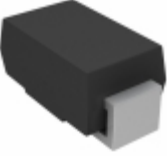
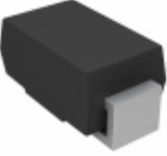
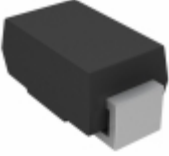



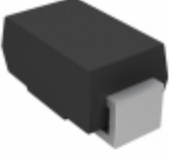
	<h2>US1GHE3_A/H</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: US1GHE3_A/H</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p> <p>Datenblätter: 1.US1GHE3_A/H.pdf 2.US1GHE3_A/H.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	US1GHE3_A/H
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	4000 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

US1GHE3_A/H ist neu im Original, Suche US1GHE3_A/H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US1GHE3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage US1GHE3_A/H: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>US1GHE3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>
 <p>US1GHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3/61 VISHAY US1GHE3/61 VISHAY</p>	 <p>US1GHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ US1B-M3/61T	↔ US1BHE3/5AT	⇒ US1BHE3/5AT	D US1BHE3/61T	↔ US1BHE3/61T
⊢ US1C-E3/61T	⊗ US1D-13-F	D US1D-E3/61T	⇒ US1D-E3/61T	↔ US1D-M3/61T
⊗ US1D-M3/61T	⊢ US1DWF-7	⊗ US1DWF-7	↔ US1G-13-F	↔ US1G-E3/61T
D US1G-E3/61T	⊗ US1G-M3/61T	⊢ US1G-M3/61T	⊗ US1G/11T	↔ US1GHE3/5AT
⇒ US1GHE3/5AT	↔ US1GHE3/61	⊗ US1GHE3/61T	⊢ US1GHE3/61T	↔ US1GHE3_A/H
↔ US1GWF-7	⇒ US1GWF-7	D US1J-13-F	⊗ US1J-5AT	⊢ US1J-E3/5AT
⊗ US1J-E3/5AT	D US1J-E3/61T	⇒ US1J-E3/61T	↔ US1J-M3/61T	↔ US1J-M3/61T
⊢ US1J/11T	⊗ US1J/61T	↔ US1JE-TP	⇒ US1K-13-F	↔ US1K-E3/61T
⊗ US1K-E3/61T	⊢ US1K-E3D/H	⊗ US1K-M3/5AT	D US1K-M3/5AT	↔ US1K-M3/61T
↔ US1K-M3/61T	⊗ US1K/11T	⊢ US1KSAFS-13	⊗ US1KSAFS-13	↔ US1M-13-F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited